



МИКРОСХЕМА ИСОЛТ216

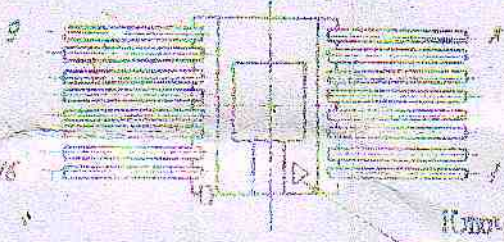
ЭТИКЕТКА

Микросхема интегральная полупроводниковая ИСОЛТ216

"Три приемника с линией"

Климатическое исполнение: В

Схема расположения выводов



Масса не более 1,5 г

Таблица назначения выводов

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
1	Общий	9	Вход X3
2	Выход Y1	10	Вход X4
3	Выход Y2	11	Спорное напряжение $U_{сп}$
4	Вход X1	12	Вход X5
5	Вход X2	13	Вход X6
6	Выход Y3	14	Выход Y5
7	Выход Y4	15	Выход Y6
8	Питание U_{cc}	16	Общий

Основные электрические параметры при $T = -25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение высокого уровня, В $U_{cc} = -5,2 \text{ В}, U_g = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}, U_{IH} = 0,810 \text{ В}$ $U_{пор} = -1,105 \text{ В}, U_{сп} = -1,475 \text{ В}, U_{IL} = -1,850 \text{ В}$	V_{OH}	-0,960	
Выходное напряжение низкого уровня, В $U_{cc} = -5,2 \text{ В}, U_g = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}, U_{IH} = 0,810 \text{ В}$ $U_{пор} = -1,105 \text{ В}, U_{сп} = -1,475 \text{ В}, U_{IL} = -1,850 \text{ В}$	V_{OL}		-1,630
Напряжение высокого уровня, В $U_{cc} = -5,2 \text{ В}, U_g = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}$ $U_{IH} = 0,810 \text{ В}, U_{IL} = -1,850 \text{ В}$	U_H	-0,960	-0,810
Напряжение низкого уровня, В $U_{cc} = -5,2 \text{ В}, U_g = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}$ $U_{IH} = 0,810 \text{ В}, U_{IL} = -1,850 \text{ В}$	U_L	-1,850	-1,650
Входной ток высокого уровня, мкА $U_{cc} = -5,2 \text{ В}, U_g = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}$ $U_{IH} = 0,810 \text{ В}, U_{IL} = -1,850 \text{ В}$	I_{IH}		115

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Ток утечки на входе, мкА $U_{cc} = -5,2 \text{ В}, U_c = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}$ $U_{i1} = -1,850 \text{ В}, U_{i2} = -2,20 \text{ В}$	I_{ct}	-	1
Ток потребления, мА $U_{cc} = -5,2 \text{ В}, U_c = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}$ $U_{i1} = -1,850 \text{ В}$	I_{cc}	-	25
Опорное напряжение, В $U_{cc} = -5,2 \text{ В}, U_c = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}$	U_{REF}	-1,350	-1,230
Время задержки распространения при включении и при выключении, нс $U_{cc1} = -3,2 \text{ В}, U_{cc2} = -2,0 \text{ В}, R_L = 51 \text{ Ом}, Z_L = 50 \text{ Ом}$			
параметры входных импульсов: $U_{i1} = (1,11 \pm 0,02) \text{ В}, U_{i2} = (0,31 \pm 0,02) \text{ В}$ $t \geq 20 \text{ нс}, t_{PLH} = t_{PHL} = (1,5 \pm 0,2) \text{ нс}$ на уровнях $(0,2 - 0,8 U_{i1}, f = 10 \text{ кГц} - 10 \text{ МГц})$	t_{PHL} t_{PLH}	-	25

Напряжение питания, U_{cc} , В, минус $5,2 \pm 5\%$

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:
 золота 14,2717 г, серебро _____ г,
 в том числе золота 18,5826 г/мм $4,63 \cdot 10^{-5}$ г/мм на 16-выводах длиной 10,75 мм.

Сведения о приемке

Микросхемы 100ЛП216 соответствуют техническим условиям 3.088.068 ТУ22.

Принято по извещению № _____ от _____

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Место для штампа: "Перепроверка произведена _____"

Принято по извещению № 10/16 от 11.05.1991

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика



26 ИЮН 1991